

# КОМПЛЕМЕНТАРНАЯ ПАРА КРЕМНИЕВЫХ ЭПИТАКСИАЛЬНО-ПЛАНАРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ со СВЕРХМАЛЫМ ПРЯМЫМ ПАДЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ

Транзисторы предназначены для применения в переключательных, импульсных схемах с низким напряжением насыщения и другой аппаратуре.

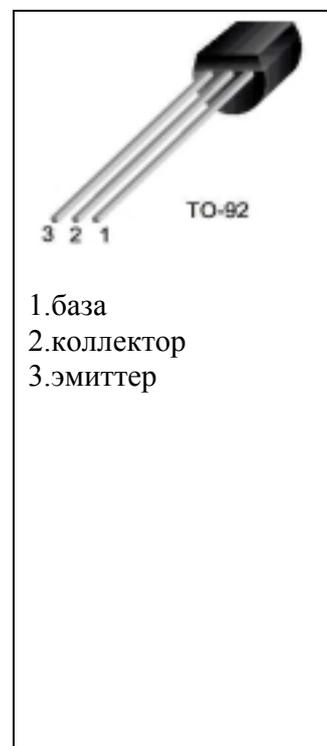
Транзисторы соответствуют АДБК 432140.943 ТУ

**pnp**  
**КТ529А**  
**npn**  
**КТ530А**

## Основные параметры

Параметр	Обозн.	КТ529 А КТ530 А	Единицы измерения
Обратный ток коллектора ( $U_{cb}=80$ В)	$I_c$	1	мкА
Обратный ток эмиттера ( $U_{eb}=4$ В)	$I_e$	1	мкА
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ( $I_c/I_b=(300/10)$ мА)	$U_{ce}$	0.2	В
Статический коэффициент передачи тока ( $U_{ce}=5$ В, $I_c=300$ мА)	$h_{21e}$	180	
Граничное напряжение ( $I_e=10$ мА)		40	В
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ( $U_{ce}=5$ В, $I_e=300$ мА, $f=100$ МГц)		1.5	

**$I_k$  max 1 А**  
 **$U_k$  max 60 В**  
 **$P$  max 0,5 W**



## Предельно-допустимые параметры

Параметр	Обозн.	КТ529 А КТ530 А	Единицы измерения
Максимальное постоянное напряжение коллектор- эмиттер	$U_{ce}$ max	60	В
Максимальное постоянное напряжение эмиттер база	$U_{eb}$ max	4	В
Максимально допустимый постоянный ток коллектора	$I_c$ max	1	А
Рассеиваемая мощность	$P$ max	0.5	Вт
Рабочая температура окружающей среды	$T_{amb}$	-60...+85	°С